

تأثیر افزودن یون کروم بر آنالیز فازی، ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنه‌های هگرافیت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد

امیرعباس نوربخش^{۱*}، محسن نوربخش^۲، مهرداد شایگان^۳ و سلین غربیان^۴

۱- استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

۲- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان

۳- کارشناس ارشد تحقیقات شرکت سرامیک نوین سپاهان

۴- کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

*nourbakhsh@iaush.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۰۷/۲۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۰۹/۱۸)

چکیده

بدنه‌های سخت مغناطیسی هگرافیت استرانسیوم همچنان اهمیت خود را در صنایع مایکروویو، ساخت موتورهای الکتریکی، صنایع کشاورزی (آبیاری بارانی) و غیره دارا می‌باشد. در تحقیق حاضر، نقش افزودن یون کروم بر آنالیز فازی، ریزساختاری و خواص مغناطیسی بدنه‌های هگرافیت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد انتخاب نسبت مولی مناسب اکسید آهن و اکسید استرانسیوم ($n = 6$)، درجه حرارت پخت اول (۱۲۱۰ درجه سانتی گراد) به منظور تشکیل فاز مغناطیسی هگرافیت استرانسیوم و درجه حرارت پخت دوم (۱۲۲۰ درجه سانتی گراد) جهت ساخت بدنه با خواص مغناطیسی مناسب در حضور افزودنی کروم الزامی می‌باشد. بررسی الگوی تفرق اشعه X به همراه اندازه گیری مشخصات ریزساختاری (SEM) نشان داد که میزان بهینه افزودنی کروم $0.3/5$ مول الگوی تفرق اشعه X به همراه اندازه گیری مشخصات ریزساختاری (SEM) نشان داد که میزان بهینه افزودنی کروم $0.3/5$ مول (SrCr_{0.3}Fe_{11.7}O₁₉) بوده و نیروی وادارندگی مغناطیسی ۳۷۱۹ Gs، مغناطش باقیمانده ۳۹۹۵ Oe و میزان مربعی شدن $83/5$ درصد گردید.

واژه‌های کلیدی:

هگرافیت استرانسیوم، افزودن کروم، خواص مغناطیسی، حالت جامد.

۱- مقدمه

بدنه‌های سخت مغناطیسی هگرافیت استرانسیوم با ساختار مگتوپلمیت و فرمول عمومی $\text{MeFe}_{12}\text{O}_{19}$ همچنان اهمیت خود را در صنایع مایکروویو، ساخت موتورهای الکتریکی، صنایع کشاورزی (آبیاری بارانی) و غیره دارا می‌باشد [۱ و ۲]. خواص بدنه‌های سخت مغناطیسی شدیداً تابع مشخصات ریزساختاری

همچون اندازه دانه‌ها، تخلخل، فازهای ثانویه و رشد انیزتروپ دانه‌ها می‌باشد [۳]. در حالی که مغناطش باقیمانده^۱ مناسب ایجاب می‌کند که بدنه دانسیته بالایی به همراه رشد انیزتروپ داشته باشد، لازم است جهت فراهم نمودن نیروی وادارندگی مغناطیسی^۲ بالا از رشد دانه‌ها جلوگیری نمود [۴]. جهت به دست آوردن شرایط فوق از فرآیندهای مختلفی در ساخت بدنه‌های

نتایج به دست آمده از بررسی‌های منحنی‌های هسیترزیس مغناطیسی را نشان می‌دهد. در نهایت خواص مغناطیسی نمونه بهینه حاوی $0/3$ مول کروم، نیروی وادارنده‌گی مغناطیسی 3995 Oe معناطش باقی‌مانده 3719 GS و میزان مربعی شدن $83/5$ درصد به دست آمد.

۲- روش تحقیق

در تحقیق حاضر جهت سنتز پودر و بدنه هگرافیت استرانسیوم که در آن یون کروم وارد ساختار ^4G گردیده از مواد اولیه آورده شده در جدول (۱) استفاده گردید. لازم به ذکر است که به غیر از اکسید آهن که از لجن صنعتی شرکت فولاد مبارکه تأمین گردیده، در بقیه موارد از مواد با خلوص بالا استفاده شده است. آنالیز شیمیایی اکسید آهن مورد استفاده در جدول (۲) آورده شده است.

جهت ساخت نمونه‌ها، در ابتدا و با توجه به خلوص مواد اولیه مقادیر متناسبی از اکسید آهن و کربنات استرانسیوم و با توجه به نسبت مولی اکسید آهن به اکسید استرانسیوم ($n = 6$) توزین گردیده و در جارمیل پلیمری مدل BP-403 و نسبت گلوله به مواد $11/1$ به $55/0$ دور در دقیقه و به مدت یک ساعت مخلوط گردید. سپس جهت مشخص نمودن دمای بهینه تشکیل هگرافیت استرانسیوم پودرهای حاصل در کوره الکتریکی مدل LH30/14، با نرخ گرمایش $10^\circ\text{C}/\text{min}$ درجه سانتی‌گراد بر دقيقه و زمان نگهداری دو ساعت در دماهای متفاوت $1140-1220^\circ\text{C}$ درجه سانتی‌گراد با فاصله دمایی 10°C درجه برای هر پخت، تحت عملیات پخت اول قرار گرفتند. از پودرهای حاصله در این مرحله الگوی تفرق اشعه X توسط دستگاه بروکر مدل D8ADVANCE ساخت آلمان و با استفاده از تابش $\text{Cu-K}\alpha$ ($\lambda = 1/540.6\text{\AA}^\circ$) به همراه فیلتر نیکل تهیه گردید. همچنین شاخص‌های نسبی خواص مغناطیسی نمونه‌ها از منحنی هسیترزیس (B-H curve) گرفته شده توسط دستگاه AMT-4 مورد بررسی قرار گرفت. سپس نمونه بهینه (بدون افزودنی

مغناطیسی استفاده گردیده است که از آن جمله می‌توان به رسوب‌دهی همزمان [۵]، سنتز هیدرоторمال [۶]، شیشه-سرامیک [۷]، فرآیند سل-ژل [۸] و سنتز خوداحتراقی [۹] اشاره نمود. از زمان کشف هگرافیت استرانسیوم در شرکت فیلیپس در سال ۱۹۵۴ تا کنون فعالیت‌های تحقیقاتی متعددی جهت بهینه‌سازی خواص این ماده استراتژیک صورت پذیرفته است [۱۰]. در میان تحقیقات صورت گرفته، مطالعات زیادی در زمینه جایگزینی کاتیون‌های مختلف در زیر شبکه‌های هگرافیت استرانسیوم به چشم می‌خورد [۱۱]. در هگرافیت‌های نوع M یون‌های آهن در پنج محل مختلف کریستالی شامل محل‌های هشت‌وجهی $2a$ ، $12k$ و $4f_2$ و محل‌های چهار وجهی $(4f_1)$ و $2b$ قرار می‌گیرند. یون‌های آهن در هگرافیت استرانسیوم در محل‌های $12k$ ، $2a$ و $2b$ دارای اسپین‌های موازی و در جهت (c) محور کریستالی بوده و این در حالی است که اسپین‌ها در محل‌های $4f_2$ و $4f_1$ به صورت موازی و در خلاف جهت سه موقعیت قبلی در کریستال گزارش شده است [۱۲]. تحقیقات بسیاری بر روی جایگزینی یون‌های مختلف همچون Ga^{+3} , Ti^{+4} , Al^{+3} , Zn^{+2} , Ce^{+3} , Pr^{+3} , La^{+3} , Co^{2+} و Mn^{+2} در ساختار هگرافیت استرانسیوم و نقش آن بر بهینه‌سازی خواص مغناطیسی انجام گرفته است [۱۳-۱۶].

فنگ و همکارانش [۱۷]، اثر جایگزینی یون کروم بر خواص مغناطیسی نانوذرات هگرافیت استرانسیوم را بررسی کرده‌اند و لی اطلاعات مدونی در زمینه نقش یون کروم به عنوان افزودنی بر بدنه‌های هگرافیت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد در دسترس نمی‌باشد. در کار تحقیقاتی حاضر سعی گردید تا نقش افزودن یون کروم سه ظرفیتی بر ساختار، آنالیز فازی و مشخصات مغناطیسی بدنه هگرافیت استرانسیوم تهیه شده به روش حالت جامد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد حد بهینه میزان افزودن مول کروم $0/3$ بوده و بالاتر از آن فاز غیر مغناطیسی همایت ظاهر می‌گردد. همچنین بررسی‌های ریزساختاری (SEM) مشخص نمود که با افزودن یون کروم، ساختار نسبتاً ریزدانه‌تری حاصل می‌گردد که تطابق خوبی با

جدول (۱): مواد اولیه مورد استفاده.

ردیف	نام ماده	فرمول شیمیایی	جرم مولی (g/mol)	دانتیته (g/cm ³)
۱	کربنات استرانسیم	SrCO ₃	۱۴۷/۶۳	۳/۵
۲	اکسید آهن	Fe ₂ O ₃	۱۵۹/۶۹	۵/۲۴۲
۳	اکسید کروم	Cr ₂ O ₃	۱۵۱/۹۹	۵/۲۲
۴	پلی وینیل الکل	(C ₂ H ₄ O) _x	۴۴	۱/۴۱ - ۱/۱۹
۵	اسید بوریک	H ₃ BO ₃	۶۱/۸۳	۱/۴۳
۶	اکسید کلسیم	CaO	۵۶/۰۷	۳/۳۵
۷	سیلیس	SiO ₂	۶۰/۰۸	۲/۲
۸	آلومینا	Al ₂ O ₃	۱۰۱/۹۶	۴/۱ - ۳/۹۴

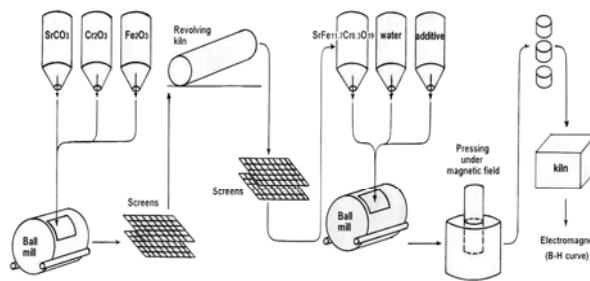
جدول (۲): آنالیز شیمیایی اکسید آهن مورد استفاده.

ترکیب	Cl	Fe ₂ O ₃	CaO	SiO ₂	MnO	Al ₂ O ₃	SO ₃	MgO	CuO	ZnO	Cr ₂ O ₃	K ₂ O	LOI	Total
درصد وزنی	۹۳/۶۸	۱/۴۱	۱/۰۵	۰/۲۷	۰/۲۲	۰/۱۲	۰/۱۲	۰/۰۸۴	۰/۰۴۲	۰/۰۲۵	۰/۰۲۱	۰/۰۱۹	۳/۱۰	۱۰۰/۱۶

نمونه‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر و پارامترهای در نظر گرفته شده جهت تولید آنها در جدول (۳) آورده شده است.

کروم) با توجه به بررسی‌های فازی و خواص مغناطیسی انتخاب و با توجه به فرمول $\text{SrCr}_x\text{Fe}_{12-x}\text{O}_{19}$ مقدار متناسبی از اکسید کروم محاسبه و پس از توزین با پودر بهینه و افزودنی‌های ردیف ۵ تا ۸ مندرج در جدول (۱) و با نسبت آب به مواد (سه به یک) در جارمیل فلزی ریخته شده و به مدت ۸ ساعت مخلوط گردید. سپس دوغاب حاصله توسط پرس تحت میدان مغناطیسی مدل C4520 تبدیل به قرص‌هایی با قطر ۳ سانتی‌متر و ارتفاع ۱ سانتی‌متر گردید. نمونه‌های حاصله در دمای بین ۱۲۶۰ تا ۱۲۱۰ درجه سانتی‌گراد و با فاصله دمایی ۱۰ درجه سانتی‌گراد و با شرایط مشابه با پخت اول تحت فرآیند پخت قرار گرفتند. از نمونه‌های حاصله الگوی تفرق اشعه X، منحنی هستیزیس و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی توسط دستگاه LEO 435 VP گرفته شد. کلیه مراحل ساخت قطعه در شکل (۱) آورده شده است.

با توجه به آنالیز اکسید آهن ارائه شده در جدول (۲) و با توجه به کمبود نسبی آهن و همچنین به دلیل خلوص نسبتاً پائین لجن صنعتی مورد مصرف، تصمیم گرفته شد که نسبت مولی اکسید آهن به اکسید استرانسیوم، شش انتخاب گردد. در تحقیقات دیگران مشاهده می‌گردد که نسبت فوق عمدتاً در محدوده (۵/۸ - ۵/۹) در نظر گرفته شده که به دلیل ایجاد جای خالی و بهبود فرآیند نفوذ و به دلیل استفاده از پودرهای خالص گزارش شده است [۱۸]. همان گونه که در شکل (۲) آورده شده است آنالیز حرارتی (DTA) بر روی پودر مخلوط شده نشان می‌دهد که دمای شروع تشکیل هگزافریت استرانسیم در حدود ۸۰۰



شکل (۱): مراحل ساخت نمونه هگزافریت استرانسیوم با افزودنی کروم.

جدول (۳): نمونه‌های مورد بررسی به همراه پارامترهای تولید.

شماره نمونه	نسبت مولی (Fe ₂ O ₃ /SrO)	نسبت مولی (Fe/Sr)	درجة حرارت پخت اول (°C)	درجة حرارت پخت دوم (°C)	مول کروم
C ₁	۶	۱۲	۱۱۸۰	-	-
C ₂	۶	۱۲	۱۱۹۰	-	-
C ₃	۶	۱۲	۱۲۰۰	-	-
C ₄	۶	۱۲	۱۲۱۰	-	-
C ₅	۶	۱۲	۱۲۱۰	۱۲۱۰	-
C ₆	۶	۱۲	۱۲۱۰	۱۲۲۰	-
C ₇	۶	۱۲	۱۲۱۰	۱۲۴۰	-
C ₈	۶	۱۲	۱۲۱۰	۱۲۶۰	-
C _{9-i}	۶	۱۱/۹	T*	۱۲۲۰	۰/۱
C _{10-i}	۶	۱۱/۷	T*	۱۲۲۰	۰/۳
C _{11-i}	۶	۱۱/۵	T*	۱۲۲۰	۰/۵

T*: i=1 → T*=121.0°C, i=2 → T*=122.0°C,

i=3 → T*=124.0°C, i=4 → T*=126.0°C

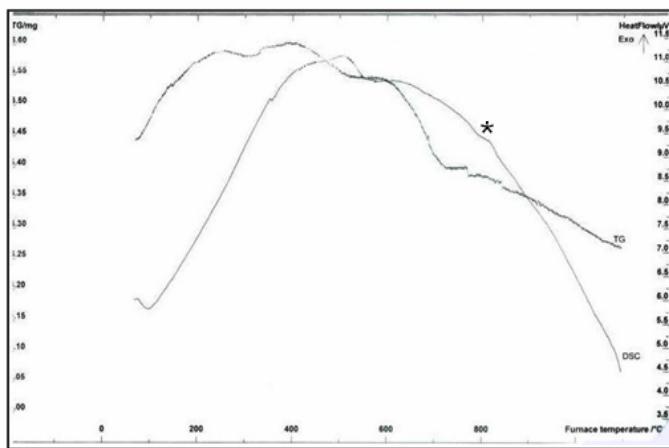
درجه سانتی گراد می‌باشد.

نتایج بررسی‌های الگوی تفرق اشعه X، نمونه‌های (C₄ - C₁) حاکی این مطلب است که هیچگونه تغییر در الگوی تفرق اشعه X با افزایش درجه حرارت پخت اول مشاهده نمی‌گردد. جهت انتخاب بهینه دمای کلسینه شدن (پخت اول)، خواص مغناطیسی پودرهای کلسینه شده (C₄ - C₁) به دست آمده از منحنی‌های هیستروگراف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جدول (۴) آورده شده است.

نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم ثابت بودن مقدار مغناطش

۱-۳-۱- انتخاب بهینه دمای پخت اول (دمای کلسینه شدن)^۰ با توجه به تشکیل فاز هگزافریت استرانسیوم در حین پخت اول، انتخاب دمای بهینه که به شرایط مواد اولیه همچون اندازه ذرات، سطح ویژه ذرات، نسبت مولی و نحوه اختلاط بستگی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

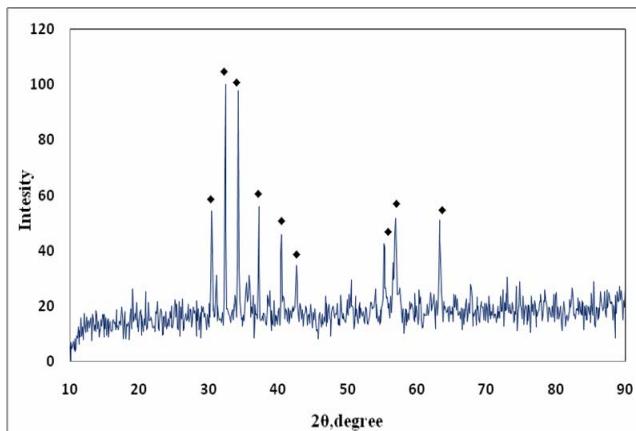
عدم تشکیل مقدار مناسب هگزافریت استرانسیوم به دلیل تشکیل فازهای میانی بر روی سطح اکسید آهن و جلوگیری از فرآیند نفوذ و همچنین کامل نشدن انقباض پودر در این مرحله مشکلات اساسی در حین فرآیند زینترینگ را به همراه خواهد



شکل (۲): آنالیز حرارتی (DTA) پودر مخلوط شده.

جدول (۴): اطلاعات مربوط به منحنی‌های هیسترزیس جهت تعیین دمای پخت اول.

شماره نمونه	دمای پخت اول (°C)	(Br)	Hcj(Oe)	Hk/Hcj(%)
C ₁	۱۱۸۰	۳۷۹۷	۳۵۲۵	۸۸/۲
C ₂	۱۱۹۰	۳۶۴۳	۳۹۲۳	۹۰
C ₃	۱۲۰۰	۳۵۳۸	۳۹۸۷	۸۸/۷
C ₄	۱۲۱۰	۳۶۷۳	۴۰۴۸	۸۷/۱

شکل (۳): الگوی تفرق اشعه X نمونه C₄ در دمای ۱۲۱۰ درجه سانتی‌گراد، ♦: هگزافریت استرانسیوم.

۱۲۱۰ درجه سانتی‌گراد برای پخت اول باشد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که انجام عملیات پخت اول در دمای بالاتر از ۱۲۱۰ درجه سانتی‌گراد باعث تفجوسی جزئی به دلیل ناخالصی همراه آهن بوده که شرایط پخت پودر در مرحله تفجوسی را طولانی تر می‌نماید. در شکل (۳) الگوی تفرق اشعه X نمونه C₄ در دمای ۱۲۱۰ درجه سانتی‌گراد آورده شده است.

باقی مانده در حدود ۳۶۰۰ گوس، نیروی وادارندگی مغناطیسی از حدود ۳۵۰۰ به حدود ۴۰۰۰ اورستد افزایش یافته است، این در حالی است که میزان مربعی شدن در حدود ۸۷ درصد گزارش شده است.

نتایج فوق که صرفاً و جهت مقایسه پودرهای کلسینه شده مورد استفاده قرار گرفته، می‌تواند دلیل مناسبی جهت انتخاب دمای

پخت دوم (تفجوشی) در جدول (۵) آورده شده است. همانگونه که از اطلاعات این جدول استنباط می‌گردد، با افزایش دمای پخت در مرحله تفجوشی، مغناطش باقی‌مانده (B_r) افزایش نسبی یافته که دلیل آن تفجوشی بهتر بدن و حذف تخلخل می‌باشد، همچنین نیروی و ادارندگی مغناطیسی (HcJ) کاهش یافته که علت آن رشد دانه‌ها در حین تفجوشی در درجه حرارت‌های بالاتر می‌باشد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول (۴) و با توجه به نیاز به بالابودن همزمان مغناطش باقی‌مانده، نیروی و ادارندگی مغناطیسی و درصد مربعی، درجه حرارت پخت دوم ۱۲۲۰ درجه سانتی‌گراد و به منظور بررسی نقش افزودن یون کروم و بهبود خواص مغناطیسی در نظر گرفته شد.

۳-۳- تعیین میزان بهینه افزودنی کروم

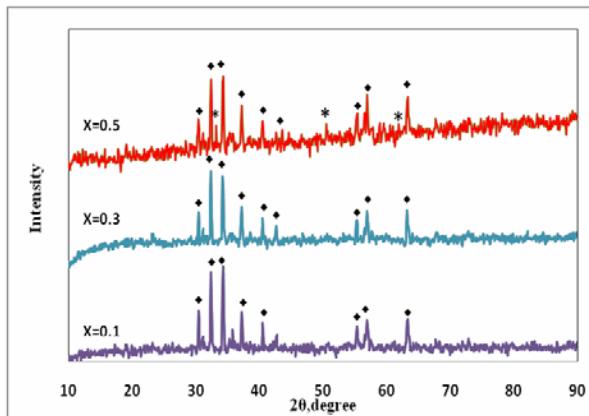
در این مرحله و جهت وارد کردن یون کروم، در ساختار هگرافیت استرانسیوم و با فرمول $SrCr_xFe_{12-x}O_{19}$ و به میزان صفر تا ۰/۵ مول کروم، از اکسید کروم با خلوص آزمایشگاهی استفاده گردید. نتایج بررسی آنالیز تفرق اشعه X، از نمونه‌های پخته شده در درجه ۱۲۲۰ درجه سانتی‌گراد در شکل (۴) نمایش داده شده است.

نتایج نشان می‌دهد که با افزودن کروم تا ۰/۳ مول هیچگونه تغییری در آنالیز فازی به وجود نیامد. این در حالی است که با افزودن ۰/۵ مول کروم به هگرافیت استرانسیوم فاز هماتیت که غیر مغناطیسی می‌باشد ظهرور می‌نماید. نتایج بررسی‌های مس با ائر⁷ توسط دیگر محققین ثابت نموده که یون Cr^{3+} در تمام موقعیت‌های Fe^{3+} به جز موقعیت تراهدرال $4f_1$ ، امکان حضور دارد [۲۰]. با توجه به تقریباً برابر بودن شعاع یونی Cr^{3+} (۶۴ پیکومتر) در برابر شعاع یونی Fe^{3+} (۶۳ پیکومتر) حضور فاز هماتیت نمی‌تواند به اندازه یونی ارتباط یابد و این موضوع به نظر می‌رسد در ارتباط با انرژی تبادلی به دلیل جایگزینی یون Cr^{3+} به جای Fe^{3+} در شبکه هگرافیت استرانسیوم باشد [۱۷]. بررسی مشخصات مغناطیسی نمونه‌های ($C_{11}-C_9$) در شکل‌های (۵) و (۶) آورده شده است. نتایج مربوط به مغناطش باقی‌مانده در شکل

جدول (۵): اطلاعات مربوط به منحنی‌های هیسترزیس

جهت تعیین دمای پخت نهایی.

شماره نمونه	دمای پخت نهایی (°C)	Br(Gs)	Hcj(Oe)	Hk/Hej(%)
C_5	۱۲۱۰	۳۹۷۵	۳۵۱۸	۹۲/۵
C_6	۱۲۲۰	۴۰۱۷	۳۴۱۴	۹۲/۹
C_7	۱۲۴۰	۴۰۳۰	۳۳۹۶	۸۹/۶
C_8	۱۲۶۰	۴۱۳۰	۲۸۸۶	۸۳/۹



شکل (۴): الگوی تفرق اشعه X نمونه‌ها ($SrCr_xFe_{12-x}O_{19}$) در دمای ۱۲۲۰ درجه سانتی‌گراد، ♦: هگرافیت استرانسیوم و *: هماتیت.

است.

۲-۲- انتخاب دمای بهینه پخت دوم (دمای تفجوشی)

جهت بهینه‌سازی دمای پخت دوم، نمونه‌های C_8-C_5 -مندرج در جدول (۳) مورد استفاده قرار گرفت. هدف این مرحله انتخاب دمای مناسب زینترینگ جهت حصول خواص مغناطیسی مناسب که شدیداً تحت تأثیر متغیرهای ساختاری می‌باشد، بوده است. جهت بهبود فرآیند زینترینگ در کار تحقیقاتی حاضر از مخلوط SiO_2 , Al_2O_3 , CaO و B_2O_3 به میزان ۱/۵ درصد وزنی استفاده گردید. بر اساس گزارش آرندت [۱۹]، استفاده از مواد افزودنی در مرحله تفجوشی حتی برای پودرهای تجاری نیز که اغلب در حدود یک درصد ناخالصی دارند، با بهبود قابل ملاحظه‌ای به ویژه در مورد نیروی و ادارندگی مغناطیسی (HcJ) همراه بوده است. نتایج بررسی‌های انجام گرفته در مورد دمای

دیگران به صورت زیر تبدیل می‌شود [۲۱]:

$$\begin{aligned} \text{Ms} = & [6(XM_{12k}^{Fe^{3+}} + (1-X)M_{12k}^{Cr^{3+}}) - 2(X\{M_{4f_2}^{Fe^{3+}} + (1-X)M_{4f_2}^{Cr^{3+}}\})] \\ & - 2M_{4f_1}^{Fe^{3+}} + [(XM_{2b}^{Fe^{3+}} + (1-X)M_{2b}^{Cr^{3+}}) + (XM_{2a}^{Fe^{3+}} + (1-X)M_{2a}^{Cr^{3+}})] \end{aligned} \quad (۲)$$

که در رابطه فوق X ، کسر مولی اشغال شده توسط یون Fe^{3+} در مواضع پنج گانه می‌باشد. با حضور یون کروم با مغناطیش کمتر، در کل مغناطیش واحد شبکه و به دنبال آن مغناطیش باقیمانده قطعه کاهش می‌یابد.

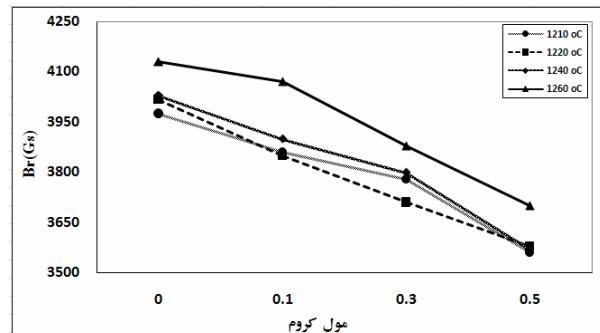
بررسی مقادیر نیروی وادارندگی مغناطیسی (Hcj) در شکل (۶) نشان می‌دهد که با افزایش میزان مول کروم در ساختار از صفر تا $0/5$ مول ($X = 0/5$) میزان نیروی وادارندگی مغناطیسی افزایش می‌یابد. به طور کلی هر چه انرژی کل یک قطعه مغناطیسی کمتر باشد، میل سیستم جهت تغییر جهت ممان مغناطیسی کمتر می‌باشد. رابطه زیر توسط محققین در ارتباط با ثابت ناهمسانگردی و مغناطیس اشباع به اثبات رسیده است [۲۲].

$$Hcj = \alpha \left(\frac{\gamma k}{Ms} \right) \quad (۳)$$

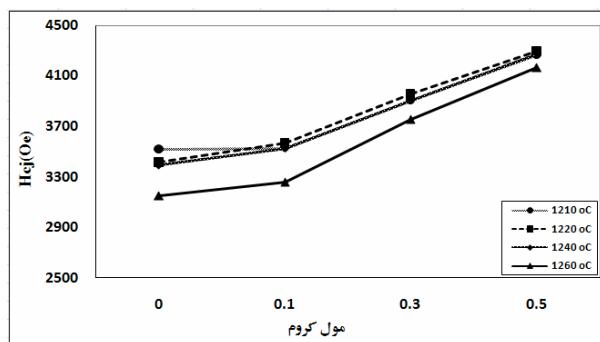
که در رابطه فوق Ms مغناطیش اشباع، K ثابت ناهمسانگردی و N فاکتور وامغناطیش می‌باشد. با توجه به رابطه اخیر و کاهش Ms ناشی از افزودن یون کروم در شبکه هگزافریت استرانسیوم و در نتیجه مغناطیش باقیمانده (Br)، می‌توان انتظار افزایش (Hcj) را داشت.

نتایج بررسی‌های ریزساختاری توسط SEM که در شکل (۷) نمایش داده شده است، مشخص نمود که با افزایش یون کروم اندازه دانه‌های هگزافریت به صورت نسبی کاهش یافته و می‌تواند دلیل افزایش نیروی وادارندگی مغناطیسی باشد، همچنین کاهش اندازه دانه‌ها می‌تواند به کاهش نفوذ بین دانه‌ای در حضور یون کروم ارتباط داشته باشد.

با توجه به بررسی‌های انجام گرفته و نیاز به بالا بودن همزمان نیروی وادارندگی مغناطیسی، مغناطیش باقیمانده و درصد مربعی شدن جهت یک قطعه مغناطیسی، نمونه شامل $0/3$ مول کروم با شاخصه‌های مغناطیسی نیروی وادارندگی مغناطیسی 3995 Oe



شکل (۵): تغییرات مغناطیش باقیمانده در نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف کروم در دماهای گوناگون.

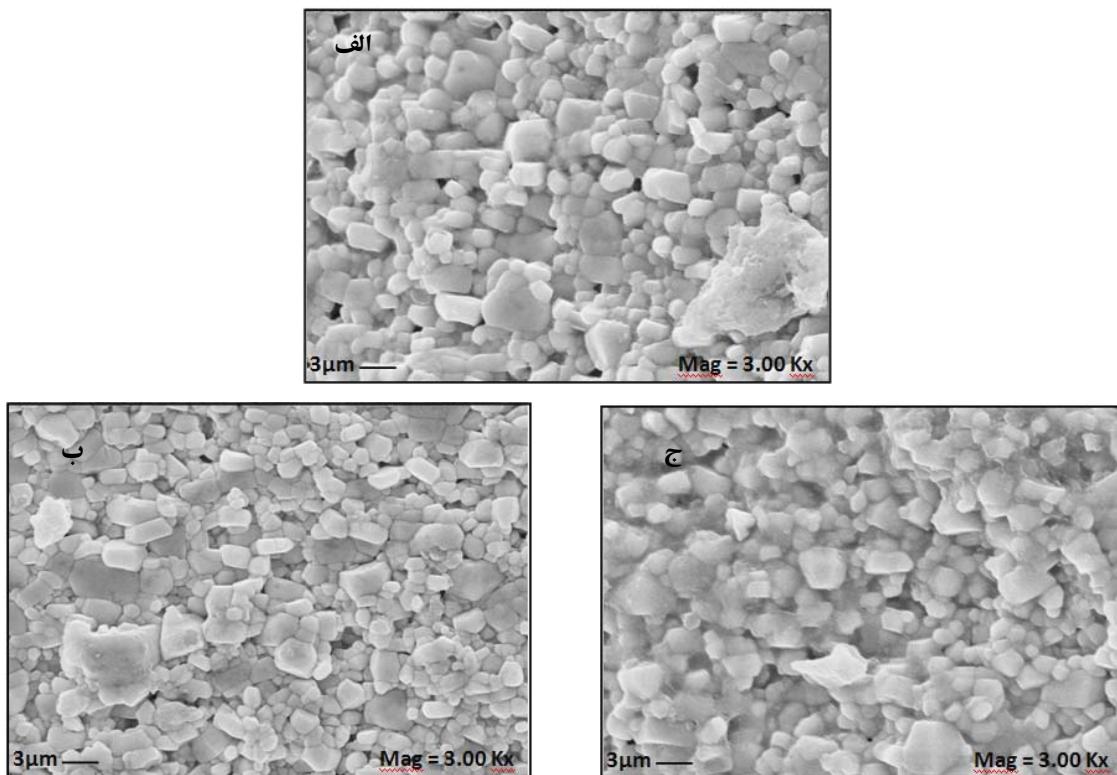


شکل (۶): تغییرات نیروی وادارندگی در نمونه‌های حاوی مقادیر مختلف کروم در دماهای گوناگون.

(۵) نشان می‌دهد که با افزایش میزان مول کروم وارد ساختار شده مغناطیش باقیمانده در تمام درجه حرارت‌های پخت کاهش یافته است. با توجه به آرایش الکترونی، میزان مغناطیش یون کروم معادل $3 \text{ مگنیون بور بوده}$ و این در حالی است که میزان مغناطیش یون آهن $5 \text{ مگنیون بور برآورد می‌گردد}$. بررسی‌های انجام گرفته در مورد واحد شبکه هگزافریت استرانسیوم نشان داده که جهت گیری اسپین‌ها در موقعیت‌های پنج گانه به صورتی است که در کل، مقدار مغناطیش 20 مگنیون بور را جهت واحد شبکه هگزافریت استرانسیوم به همراه دارد، این موضوع با رابطه زیر نمایش داده می‌شود [۱۹].

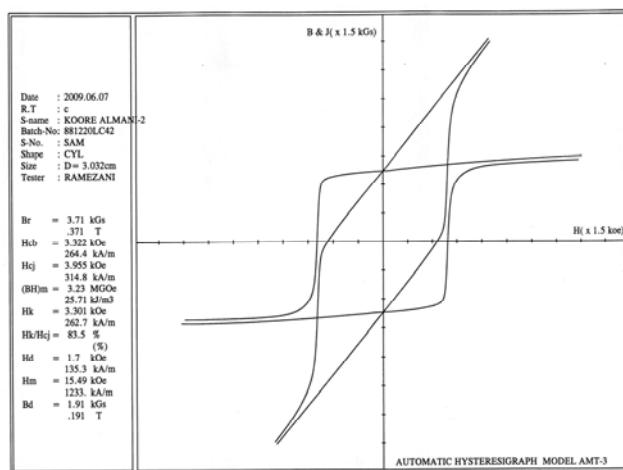
$$Ms = 6M_{12k}^{Fe^{3+}} - 2M_{4f_2}^{Fe^{3+}} - 2M_{4f_1}^{Fe^{3+}} + M_{2b}^{Fe^{3+}} + M_{2a}^{Fe^{3+}} \quad (۱)$$

این رابطه در مورد هگزافریت استرانسیوم جایگزین شده با عناصر دیگر و با توجه به بررسی‌های مس با اثر انجام گرفته توسط



شکل (۷): تصاویر ریزساختار نمونه‌های پخته شده در 1220°C ،

(الف): $1/3$ مول کروم، (ب): $0/5$ مول کروم و (ج): $0/0$ مول کروم.



شکل (۸): منحنی هیسترزیس نمونه بهینه حاوی $1/3$ مول کروم

$(\text{SrCr}_{1/3}\text{Fe}_{11/7}\text{O}_{19})$

۴- نتیجه‌گیری
نتایج بررسی‌های فوق نشان داد که انتخاب نسبت مولی مناسب $n = 6$ به همراه درجه حرارت پخت اول (کلسیناسیون) و 1210°C

مغناطش باقی‌مانده 3719 Gs و میزان مربعی شدن $83/5$ درصد به عنوان نمونه بهینه انتخاب گردید که منحنی هیسترزیس آن در شکل (۸) آورده شده است.

- [4] S. Besebicar and M. Drfenik, "High Coercivity Sr Hexaferrites", Journal of Magnetism and Magnetic Material, Vol. 101, pp. 307-309, 1991.
- [5] A. Ataei and S. Heshmati-Manesh, "Synthesis of Ultra-fine Particles of Strontium Hexaferrite by a Modified Co-Precipitation Method", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 21, pp. 1951-1955, 2001.
- [6] J. F. Wang, C. B. Paton, R. Cirossinger, I. R. Harris, "A Study of La-Substituted Strontium Hexaferrite by Hydrothermal Synthesis", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 369, pp. 170-177, 2004.
- [7] M. Mirkazemi, V. K. Marghusiham, A. Beitollahi, "Crystallization Behavior, Microstructure and Magnetic Properties of BaO-Fe₂O₃-B₂O₃-SiO₂ Glass Ceramic", Ceramic International, Vol. 32, pp. 43-51, 2006.
- [8] R. B. Jotania, R. B. Khomane, C. C. Chauhan, S. K. Menon, B. D. Kulkari, "Synthesis and Magnetic Properties of Barium-Calcium Hexaferrite Particles Prepared by Sol-Gel and Microemulsion Techniques", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 310, pp. 2477-2479, 2002.
- [9] L. Junliang, Z. Yanwei, C. Cuijing, Z. Wei, Y. Xiaowei, "One Step Synthesis of Barium Hexaferrite Nano-Powder Via Microwave Assisted Sol-Gel Auto Combustion", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 30, pp. 993-997, 2010.
- [10] R. J. Parker, "Advances in Permanent Magnet", John Wiley and Sons Inc, 1990.
- [11] K. S. Martirosyan, N. S. Martirosyan and A. E. Chalykh, "La⁺³ and Ce⁺³ Doping of Hard-Magnetic Ferrite", Inorganic Materials, Vol. 40, pp. 611-616, 2004.
- [12] A. Goldman, "Modern Ferrite Technology", Newyork Nostrand Reinhold, 1990.
- [13] L. Q. You, J. Zheng, "The Magnetic Properties of Strontium Hexaferrite with La-Cu Substitution Prepared by SHS Method", Journal of Magnetism and Magnetic Material, Vol. 318, pp. 74-78, 2007.
- [14] J. F. Wang, C. B. Ponton, J. R. Harris, "A Study of Pr-Substituted Hexaferrite by Hydrothermal Synthesis", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 403, pp. 104-109, 2005.
- [15] K. S. Martirosyan, N. M. Martirosyan, A. E. Chalykh, "La⁺³ and Ce⁺³ Doping of Hard Magnetic Ferrite", Inorganic Material, Vol. 40, No. 5, pp. 527-532, 2004.
- [16] M. J. Iqbal, M. N. Ashiq, "Comparative Studies of SrZr_xMn_xFe_{12-x}O₁₉ Nanoparticles Synthesized by Co-Precipitation and Sol-Gel Combustion Method", Scripta Materials, Vol. 56, pp. 145-148, 2007.
- [17] Q. Fang, H. Cheng, K. Huang, J. Wang, R. I. Li, "Doping Effect on Crystal Structure and Magnetic Properties of Chromium-Substituted Strontium Hexaferrite Nanoparticles", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 294, Issue 3, pp. 281-286, 2005.

درجه سانتی گراد و درجه حرارت پخت دوم (تفجوشی) ۱۲۲۰ درجه سانتی گراد جهت ساخت بدنہ با خواص مغناطیسی مناسب در حضور افزودنی کروم الزامی می باشد. همچنین بررسی های فازی مشخص نمود که حد بهینه افزودن یون کروم ۰/۳ مول بوده و در بالاتر از آن فاز غیر مغناطیسی هماتیت ظهور می یابد. میزان کاهش مغناطش باقیمانده در اثر افزایش میزان یون کروم در شبکه به مغناطش کمتر یون Cr⁺³ نسبت داده می شود. در همین رابطه افزایش نیروی وادارندگی مغناطیسی نیز به دلیل کاهش مقدار Ms در اثر جانشینی یون Cr⁺³ به جای Fe⁺³ می باشد.

بررسی های ریزساختاری SEM نشان داد که یون کروم احتمالاً به دلیل کاهش نفوذ بین دانه ای و به دلیل اندازه بزرگتر آن باعث جلوگیری از رشد دانه در مرحله تفجوشی شده و همین عامل باعث تشکیل ریزساختار ریزتر شده که افزایش نیروی وادارندگی مغناطیسی را به همراه دارد. این در حالی است که افزودن مقادیر بیشتر کروم باعث کاهش خواص مغناطیسی قطعه به دلیل خروج Fe⁺³ به صورت هماتیت از شبکه هگزافریت استرانسیوم می باشد.

۵- تشكر و قدردانی

نویسندها مقاله از زحمات پرسنل و مدیریت محترم شرکت گسترش مواد مغناطیسی تابان که نهایت همکاری را در راه انجام این تحقیق داشته اند، سپاسگزاری نموده و همچنین از ریاست و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا که با حمایت های مالی زمینه انجام این فعالیت را به وجود آوردهند، کمال تشکر و قدردانی را می نماید.

۶- مراجع

- [1] J. D. Liringston, "The History of Permanent Magnetic Materials", Jox, Vol. 42 , No. 2, pp. 30-34, 1990.
- [2] C. Gabrielli, R. Jaoulli, G. Maurine and M. Keddam, "Magnetic Water Treatment for Scale Prevention", Water Reasearch, Vol. 35, Issue 13, pp. 3249-3259, 2001.
- [3] X. Liu, W. Zhong, S. Yang, Z. Yu, B. Gu and Y. Ou, "Structurte and Magnetic Preparation of La⁺³-Substituted

- [22] Ch. Kittel, "Introduction to Solid State Physics", Wiley Eastern Limited, Fifth Edition, 1983.
- [18] H. Kajima, "Fundamental Properties of Hexaferrite with Magneto-Plumbite Structure", Edited by E. P. Wohlfarth, North-Holland, Amsterdam, pp. 305-391, 1982.
- ۷- پی نوشت**
- 1- Remanence Magnetization
 2- Magnetic Intrinsic Coercivity
 3- Rectangularity Ratio
 4- Doped
 5- Calcination Temperature
 6- Sintering
 7- Mossbauer
- [19] R. H. Arendtm, "Liquid-Phase Sintering of Magnetically Isotropic and Anisotropic Compacts of $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$ and $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ ", Journal of Applied Physics, Vol. 44, pp. 3300-3305, 1973.
- [20] P. M. Rao, A. Gerard and F. Grandjean, "Mossbauer Study of the Hexagonal Ferrite Series $\text{SrFe}_{12-x}\text{Cr}_x\text{O}_{19}$ ", Journal of Magnetism and Magnetic Material, Vol. 15-18, pp. 645-646, 1980.
- [21] P. M. Rao, A. Gerardo, "A Mossbauer Study of the Effect of the Substitution of Fe by Cr in $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ ", Phys. Stot. Sol., Vol. 54, pp. 529-536, 1979.